This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Appln. No.: 09/993,692 Fled: 11/22/01 Inventors: Noritaka Mochienki, et al. CFO /6000 US (fu Out Unit: 2819

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application: 2001年 6月22日

出願番号。 Application Number: 特顯2001-189722

出 願 Applicant(s):

キヤノン株式会社

FEB | 5 2002 TECHNOLOGY CENTER 2800

2001年12月28日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】 特許願

【整理番号】 4448014

【提出日】 平成13年 6月22日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05B 33/14

【発明の名称】 表示装置

【請求項の数】 11

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 望月 則孝

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 桜永 昌徳

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 徳田 隆二

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 瀬谷 通隆

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 星光

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】 御手洗 冨士夫

【代理人】

【識別番号】 100065385

【弁理士】

【氏名又は名称】 山下 穣平

【電話番号】 03-3431-1831

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-370647

【出願日】 平成12年12月 5日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-398283

【出願日】 平成12年12月27日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2001-62055

【出願日】 平成13年 3月 6日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010700

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703871

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板上に堆積した透明電極と、前記透明電極上に積層した電界発光(EL)層と、前記電界発光層上に積層した反射電極とを含むEL素子の配列と、

前記EL素子の各々を被覆する角錐台形状又は円錐台形状の透明体と、

前記透明体の表面に堆積された反射膜とを含み、

前記EL素子を画像信号に応じて発光させることを特徴とする表示装置。

【請求項2】 透明基板上に堆積した透明電極と、前記透明電極上に積層した電界発光(EL)層と、前記電界発光層上に積層した反射電極とを含むEL素子の配列と、

前記EL素子の各々を被覆する透明体と、

前記透明体の表面に堆積された反射膜とを含み、

前記透明基板とEL素子を画像信号に応じて発光させる表示装置であって、

前記透明体の一部の表面の曲率は正であり、前記透明基板と接触する部分の曲率は負であることを特徴とする表示装置。

【請求項3】 前記透明体による凹面鏡の焦平面を前記EL素子内部に位置させることを特徴とする請求項2記載の表示装置。

【請求項4】 前記EL素子毎にそのEL素子を発光させる駆動素子を更に含み、前記EL素子及び前記駆動素子とを前記透明体によって被覆することを特徴とする請求項1又は2記載の表示素子。

【請求項5】 前記透明体の間を埋める絶縁物質と、前記絶縁物質上に形成された配線とを更に備え、

前記配線を、前記EL素子の反射電極及び透明電極に接続することを特徴とする請求項1又は2記載の表示素子。

【請求項6】 前記透明体の間を埋める絶縁物質と、前記絶縁物質上に形成された配線とを更に備え、

前記配線を、前記駆動素子に接続することを特徴とする請求項4記載の表示素

子。

【請求項7】 前記透明基板と前記透明電極との間に、シリカエアロゲル層を形成することを特徴とする請求項1又は2記載の表示装置。

【請求項8】 前記透明基板と前記透明電極との間にハーフミラーを設け、 前記ハーフミラーと前記反射電極との間の光路長を発光波長と等しくすることを 特徴とする請求項1又は2記載の表示装置。

【請求項9】 前記透明基板と前記透明電極との間にハーフミラーを設け、前記ハーフミラーと前記反射電極との間の光路長を発光波長の1/2の整数倍とすることを特徴とする請求項1又は2記載の表示装置。

【請求項10】 前記反射電極と前記ELとの間に光吸収層を設け、

前記光吸収層の屈折率は、前記EL層の屈折率より低いことを特徴とする請求 項1又は2記載の表示装置。

【請求項11】 前記EL層上に電子輸送層を設け、更に前記電子輸送層上に光吸収層を設けて前記反射電極に接触させ、

前記光吸収層の屈折率は、前記電子輸送層の屈折率より低いことを特徴とする 請求項1又は2記載の表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】

本発明は、表示素子に関し、特に、表示画素である電界発光(EL)素子から 発光された光を高い効率で外部に取り出すことができる表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来、EL素子から発光された全光量のうち外部に取り出すことができる光量 の比率はそれほど大きくはない。

[0003]

E L素子の基本構造は、透明基板上に透明電極を堆積し、その上にE L層、反射電極を順次積層した構造である。そのため、透明基板と透明電極との境界B 1、及び透明基板と空気との境界B 2 で全反射が起こる。ここで、たとえば、透明

電極の屈折率を1.8、透明基板の屈折率を1.5とすると、境界B1による全反射のためにEL素子内に閉じ込められる光量は、全発光光量の約51%であり、境界B2による全反射のためにEL素子内に閉じ込められる光量は、全発光光量の約32%である。従って、透明基板から外部に取り出すことができる光量は、全発光光量の約17%に過ぎない。

[0004]

図13は、上述した基本構造に、断面が台形状の透明体を付加して、光の取出し効率を高めたEL素子の断面図である。このEL素子は、 Optics Letters, MaRch 15、1997、pp396-398に開示されている。

[0005]

このEL素子は、EL層110が反射電極100と透明電極120とでサンドイッチされ、そのサンドイッチ構造が透明体140上に積層され、透明体140は透明基板150上に形成されている。

[0006]

2次元表示装置に応用する場合には、透明体140の形状は、たとえば、四角 円錐台である。そして、透明体140の斜面には反射膜130が形成されている

[0007]

ここで、透明体140の屈折率を透明電極の屈折率より大きくすれば、境界1 で全反射は起こらない。

[0008]

更に、透明基板150と空気の境界2で全反射が生じてもその全反射光 I 2 は 反射膜130で反射されて、透明基板150の外部すなわち空気側に取り出される。

[0009]

又、透明体140と透明基板150との境界3で全反射が生じても、その全反射光I₃も反射膜130で反射されて、透明基板150の外部に取り出される。

[0010]

尤も、EL層110、透明電極120から直接に反射膜130に当たる光が空気側に出ていくことは当然である。

[0011]

このようにして、EL層で発光した光はより有効に外部に取り出すことができる。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上述した従来の技術では、透明体140の斜面上の反射膜130が金属である場合には、透明電極120や反射電極100に接触してはならない。従って、反射膜の形成は容易ではない。

[0013]

又、EL層を含むサンドイッチ構造が外気に触れることがないように保護膜で 覆う必要がある。

[0014]

そこで、本発明は、表示装置のEL層で発光した光を高い効率で外部に取出す とともに、EL層を含むサンドイッチ構造を外気に触れることがないよう保護す る構造を提供することを課題としている。

[0015]

【課題を解決するための手段】

上記の課題を解決するための本発明は、透明基板上に堆積した透明電極と、前記透明電極上に積層した電界発光(EL)層と、前記電界発光層上に積層した反射電極とを含むEL素子の配列と、前記EL素子の各々を被覆する角錐台形状又は円錐台形状の透明体と、前記透明体の表面に堆積された反射膜とを含み、前記EL素子を画像信号に応じて発光させるようにしている。

[0016]

本発明において、EL層を保護する透明体は、前記透明体の一部の表面の曲率 は正であり、前記透明基板と接触する部分の曲率は負であってもよい。

[0017]

又、透明体が球体の一部である場合には、前記透明体による凹面鏡の焦平面を

前記EL素子内部に位置させてもよい。

[0018]

又、前記EL素子毎にそのEL素子を発光させる駆動素子を更に含み、前記E L素子及び前記駆動素子とを前記透明体によって被覆してもよい。

[0019]

又、前記透明体の間を埋める絶縁物質と、前記絶縁物質上に形成された配線と を更に備え、前記配線を、前記EL素子の反射電極及び透明電極に接続してもよい。

[0020]

又、前記透明体の間を埋める絶縁物質と、前記絶縁物質上に形成された配線と を更に備え、前記配線を、前記駆動素子に接続してもよい。

[0021]

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。

[0022]

図1は、本発明の表示装置の1画素分の断面図である。断面が台形状の透明体 140でEL素子300が被覆されている。従って、透明体140はEL素子を、 外気から保護している。

[0023]

又、透明体140の表面全体は反射膜130で覆われている。

[0024]

このようなEL素子300の反射電極100と透明電極120との間に電圧を 印加すると電界発光(EL)層110が発光する。

[0025]

EL層110において発光した光の一部は透明電極120と透明基板150の境界B1で全反射される。この全反射光は反射膜130で反射され、透明基板150を透過して空気中に取り出される。この全反射光は、反射膜130で反射された後境界B1、B2で屈折されるが、簡単のために、直進するように描かれている。

[0026]

又、EL層110からの光の他の一部は境界B1で屈折され透明基板150と 空気との境界B2で全反射される。しかし、この全反射光も反射膜130で反射 され、透明基板150を透過して空気中に取り出される。

[0027]

このようにして、EL素子300で発光した光が効率良く外部に取り出される

[0028]

図2A、図2B、図2Cは、このようなEL素子300の配列の製造工程図である。

[0029]

まず、図2Aに示すように、ガラスやプラスチック等の透明基板150上にITO等の透明電極120、次に、有機又は無機のEL層110、次に、金属膜による反射電極100を順次積層する。そして、パターンエッチングによって、EL素子300の配列を形成する。そして更に、酸化チタン等の透明層140を形成する。

[0030]

次に、図2Bに示すように、透明層140をエッチングして、斜面145を形成する。

[0031]

そして、最後に、図2Cに示すように、金属膜又は誘電体膜による反射膜を前面に堆積させると、EL素子300の所望の配列ができあがる。

[0032]

図3は、透明体130の斜面にのみ反射膜130を形成した場合の断面図である。このような構造は、透明物体130の表面全面に反射膜を堆積した後、フォトエッチングで上面141上の反射膜を除去することによって得られる。図中、境界B1、B2において全反射された光は、反射膜130で反射された後、境界B1、B2で屈折されるが、簡単のために、直進するように描かれている。

[0033]

この構造によって台形の上辺141からの放熱が促進される。

[0034]

図4Aは、EL素子300及びこれを駆動するTFT等の駆動素子を透明体140で被覆した本発明の表示素子の平面図である。

[0035]

上面141を有する四角錐台の透明体140の表面は図示しない反射膜で被覆されている。そして、この透明体140の中にはEL素子300及びTFT等の駆動素子400が入っている。但し、簡単のために、EL素子300及びTFT等の駆動素子400との間の配線は図示していない。更に、駆動素子400は、行方向配線600及び列方向の配線700にそれぞれ接続されている。

[0036]

図4Bは、図4AのXX'断面図である。図4Bに示すように、透明体140同士の隙間を絶縁体800で充填する。そして、絶縁体800上に配線600、700を形成して、EL素子300を2次元表示画面の画素として発光させるようにする。

[0037]

配線工程においては、具体的には、たとえば、絶縁体800にスルーホールを 形成して、駆動素子400からの配線701と列方向配線700と接続する。行 方向も同様である。

[0038]

図4A、図4Bにおいては、EL素子300を駆動素子400を介して列方向 配線700及び行方向600に接続したが、駆動素子400を介さず直接列方向 配線700及び行方向600に接続してもよい。

[0039]

又、これまでの説明においては、透明体140を四角錐台として説明したが、 透明体140は円錐台であってもよい。

[0040]

更に、透明体140は球体の一部であってもよい。

[0041]

図5は、本発明の表示素子に使用するEL素子1素子分の断面図である。図5に示すように、透明体140の一部が球体の一部である。具体的には、透明体140の頂上部は正曲率の球体の一部であり、透明基板150と接する裾の部分は 負曲率の斜面となっている。

[0042]

このような透明体400は、たとえば、プラスチックの高温の溶液をEL素子 に滴下し固化させれば得られる。裾部の傾斜は、透明基板150と液滴である透 明体140の接触角によって定まる。

[0043]

裾部の傾斜は、固化する前に球体の頂上を押圧して制御することもできる。

[0044]

このようなEL素子の反射電極100と透明電極120の間に電圧を印加すると電界発光(EL)層110が発光する。

[0045]

EL層110からの光の一部は透明電極120と透明基板150の境界B1で全反射される。この全反射光は透明体140の裾部の反射膜130で反射され、透明基板150を透過して空気中に取り出される。この全反射光は、反射膜130で反射された後境界B1、B2で屈折されるが、簡単のために、直進するように描かれている。

[0046]

又、EL層110からの光の他の一部は境界B1で屈折され透明基板150と 空気との境界B2で全反射されている。この全反射光も透明体400の裾部の反 射膜130で反射され、透明基板150を透過して空気中に取り出される。

[0047]

この場合、透明体140の頂上部Sには光は殆ど到達しない。EL素子の端面にほぼ垂直に進行する光は境界B1で全反射されずに透明基板を透過し、空気側に取り出されている。従って、頂上部Sが歪んでいて球面からずれていても構わない。

[0048]

このようにして、EL素子300で発光した光が効率良く外部に取り出される

[0049]

図6は、図5の透明体140による凹面鏡の焦平面をEL素子内部に位置させた場合の断面図である。

[0050]

E L 層 1 1 0 の端面から出射した光は、透明体 1 4 0 の凹面鏡部分で反射されれば、ほぼ平行光束となって透明基板 1 5 0 から外部に取り出される。

[0051]

又、透明体140の裾部では境界B1、B2からの全反射光が反射されて外部の空気層に取り出されるため、外部に取り出される光量は更に増加する。

[0052]

この場合、透明体140の頂上部Sには光は殆ど到達しない。EL素子の端面にほぼ垂直に進行する光は境界B1で全反射されずに透明基板を透過し、空気側に取り出されている。従って、頂上部Sが歪んでいて球面からずれていても構わない。

[0053]

図5及び図6においては、凹球部が透明基板150に接しているが、凹球部を 持たぬ正球部だけの一部によっても、凹球部に近い作用は得られる。

[0054]

図7は、透明基板150に溝152を設けた本発明の表示素子の1 画素分の断面図である。溝152はE L素子300を充分カバーする大きさとする。又、薄い二酸化チタン(TiO_2)等の透明部材151の上にE L素子300が形成される。従って、溝部152は空隙となっている。

[0055]

E L素子300より透明部材151及び空隙152を透過して基板150に入射する光は基板150で全反射されることはない。透明基板150内の全反射光が他の画素へ伝播することはないし、基板150内に光が閉じ込められることもないため、E L素子300からの光は反射球体によって有効に空気側に取り出さ

れる。

[0056]

図7には、球体上の透明体140を例示したが、これに代えて、四角円台や円 錐台上の透明体を用いてもよい。

[0057]

図8には、基板ガラス211上にシリカエアロゲル210屈折率1.03をつけたものを示す。シリカエアロゲル210に空中から入射する光212はシリカエアロゲル210と基板ガラスの境界233でスネルの屈折の法則に従って屈折して光214となり更に基板ガラス211の下面234から空中へ光215となって出る。基板ガラス211は自身より低い屈折率ではさまれている為基板ガラス内で全反射が生じない。しかし境界233へ入射する光213は境界233でフレネル反射により正反射方向に反射される光216が出てくる。その強さは光213が基板ガラスに平行に近くなるに従い増す。

[0058]

図9には、基板ガラス211上にシリカエアロゲル210、ITO217、発 光層OEL218、陰極219と堆積したものを示す。OEL218の一点22 0から出た光221はITO217、シリカエアロゲル210を透過しシリカエ アロゲル210と基板ガラス211の境界233に達する。境界233でフレネ ル反射を受けた光225は正反射光向にシリカエアロゲル210内を伝播してゆ く。この伝播光は図示されてないが隣接するOEL発光素子群に入り込んで、そ こで乱反射を受けて観測方向へ出る即ち入り込まれた発光素子群にとっては不要 なノイズ光となりまたその光の発光元の発光素子の光の利用率を考えると光口ス を生じた為光利用率が実質的には低下したことになる。

[0059]

図10には、この様に不要なノイズ光を生じさせぬ為の方策が示されている。 シリカエアロゲル210は発光素子群235とほぼ同じ位の大きさとしてもよい 。OEL218の一点226から射出した光でシリカエアロゲル210と基板ガ ラス211の境界234でフレネル反射を受けた光229は透明物体140の反 射膜130で反射され光230となり空中へ射出する。即ちフレネル反射を受け た光は不図示の隣接する発光素子群に入り込むことがなくなる。また基板ガラス 内での全反射光も生じなくなる。

[0060]

図11には、隣接発光素子間を絶縁体で埋め込んだ場合を示す。241は、EL、242はITO、243は陰極、244はシリカエアロゲル等の低屈折率光透過物質、245は、反射膜、250、247は金属導電体、246はTFT、249はガラス基板、248は隣接発光素子間を埋めたポリイミドやプラスチックである。

[0061]

図12には、図11の系のEL部の1点261から出た光が有効に利用される 状態を示す。点261からガラス基板249の上面270に直接当たった光25 1は屈折して光252となって空中へ抜けるが、フレネル反射した光253は斜 面の反射膜245で反射して光254となり空中へ抜ける。点261から出てI TO242とシリカエアロゲル等の低屈折率光透過物質との境界で全反射した光 257は斜面の金属導電体250で反射して光258となって空中へ抜ける。点 261から出てEL241内部を走った光259は斜面の金属導電体250で反 射して光260となって空中へ抜ける。

[0062]

なお、反射膜245と金属導電体250のつくる三角形の頂点で両者が接しないように、図示しない若干の間隙を設ける。

[0063]

ところで、ホール/電子輸送層を含むELと謡曲ITOをミラーで挟み、その間隔の光路長をELの発光波長と同じにし、共振器とすると、光が増幅される。従って、陽極側をハーフミラーにすると増幅された光が取出される。透明基板に垂直な方向への強度の増大の大きさGは各ミラーの反射率すなわち陰極反射率Rc及びハーフミラー反射率Rhに依存し、例えば、月刊ディスプレー、1998年、10月号pp107に示されているように、

G = (1+(Rc) ^{1/2}) ²・(1-Rh) / (1-(Rc・Rh) ^{1/2}) ²となる。 【0064】 ここで、Rcを90%、Rhを0%とすると、共振器構造を取らない通常の素子に比べてGは3.8倍となる。さらに、たとえば、Rcを90%、Rhを85%とすると、GはRcを90%、Rhを0%としたときの9.5倍となる。

[0065]

尤も、Gは、Rc、Rhに応じて高くすることも低くもすることもできる。従って、このような構成を持ったものをディスプレーに使用すれば、非常に明るい画面が得られる。このようなディスプレーを明るい場所で見る場合、Rhを高くすると、背景光、室内光も反射されてディスプレーが見にくくなる。しかし、プロジェクターのように暗い場所で使用する場合には、ハーフミラーによる背景光、室内光の反射はあまり問題とはならない。そこで、EL素子とハーフミラを組み合わせ、透明基板に垂直な方向の光を増大させ、上述した斜めミラーによる光量増加分と併せて、プロジェクターによる投影画面上での照度を増大させることができる。

[0066]

図13、図14に示すように、基板ガラス150の上にハーフミラー160を 設け、その上に陽極である透明電極120が設けられている。この構造をプロジェクターに応用する。

[0067]

ハーフミラー160は、たとえば、 $TiO_2/SiO_2/TiO_2/SiO_2$ の4層構造であり、各層の光路長はそれぞれ1/4波長であり、 SiO_2 側を基板ガラス150上に堆積させるようにすればよい。

[0068]

図15に示すように、図13,図14に示したEL構造を用いる表示装置400の画面を投影レンズ401によって、投影像面402に投影する。これによって、従来に比べて各段に明るい投影像が得られる。

[0069]

又、一般に、ハーフミラー160は、 TiO_2/SiO_2 のペアが数組構造されたものであって SiO_2 側を基板ガラスに接したものであってもよい。

[0070]

図17(a)には、 TiO_2/SiO_2 のペアが4組構造された8層構造のハーフミラー160の膜構成の一例を示す。ITOは透明電極120であり、Gはガラス等の透明基板150である。

[0071]

図17(b)は、上述した8層構造のハーフミラー160の垂直入射に対する 反射率のグラフである。

[0072]

図18(a)は、波長400nmから700nmの範囲で、入射角30度の範囲における、上述した8層構造のハーフミラー160のS偏光の反射率のグラフである。

[0073]

図18(b)は、波長400nmから700nmの範囲で、入射角30度の範囲における、上述した8層構造のハーフミラー160のP偏光の反射率のグラフである。

[0074]

図18(c)は、波長400nmから700nmの範囲で、入射角30度の範囲における、上述した8層構造のハーフミラー160の平均反射率、すなわち(S偏光反射率+P偏光反射率)/2の値を示すグラフである。

[0075]

図19は、入射角0°における、上述した8層構造のハーフミラー160の反射率、透過率、及び反射波・透過波の位相を示す表である。

[0076]

図20は、波長400nmから700nmの範囲で、入射角30度の範囲における、上述した8層構造のハーフミラー160のS偏光の反射率の表である。

[0077]

図21は、波長400nmから700nmの範囲で、入射角30度の範囲における、上述した8層構造のハーフミラー160のP偏光の反射率の表である。

[0078]

図22は、波長400nmから700nmの範囲で、入射角30度の範囲にお

ける、上述した8層構造のハーフミラー160の平均反射率、すなわち(S偏光 反射率+P偏光反射率)/2の値を示す表である。

[0079]

このように、上述した8層構造のハーフミラー160の反射率は、入射角30度の範囲内においては、可視光の範囲ではほぼ一定で50%となっている。Rcが90%、Rhが50%であるときは、光の強度的増大Gは上述したGを求める式によれば共振機構造を取らない通常の素子に比べてGが17倍となる。従って、このハーフミラーを用いると、NA=sin30°、すなわちFナンバ1までのレンズの開口いっぱいまで使って像面への光量は17倍増大する。

[0080]

又、上述下4層又は8層のハーフミラー160と反射電極100との間の光路 長は、EL素子の発光波長の1/2に等しくてもよいし、発光波長の1/2の整 数倍であってももよい。

[0081]

又、陰極すなわち反射電極100はアルミニウム(A1)等の金属物質であるため、EL発光層110からの光はもとより、観測方向からの外部光も反射する。しかし、外部光が反射されると表示装置のコントラストが低下する。従って、外部光の反射を無くすか低減しなければならない。外部光の反射を低減するために、陰極を2層構造とし、EL発光層110側を光吸収層とし、もう1層をA1等の電極層とすることが特開平8-8065号公報に開示されている。

[0082]

そこで、本発明においては、EL発光層側の光吸収層の屈折率をEL発光層110の屈折率より低くすることにより、光吸収層100aとEL発光層110の界面で全反射を生じさせる。このようにすれば、全反射によって再びEL発光層内に戻って、ミラー130で反射されるので、表示装置からの光量が増加する。

[0083]

図23、図24は光吸収層100aを備えた本発明の表示装置の1画素分の断面図である。

[0084]

EL発光層110のalqの屈折率は1.73程度であるから、光吸収層100aにはたとえば屈折率1.70のMGOが好適である。EL発光層110に電子輸送層が設けられている場合には、光吸収層100aの屈折率をその電子輸送層の屈折率より低くするとよい。

[0085]

図23において、EL発光層110からの光1003は光吸収層100aとE L発光層110の界面で全反射されて光1004となり、更に、反射膜130で 反射されて光1005となり、表示装置の外部に出射する。

[0086]

図24においても同様である。

[0087]

【発明の効果】

以上説明した本発明によれば、台形状の透明体を形成したあとで、EL素子を 外気から遮断する保護膜を形成する必要がない。

[0088]

又、台形上の透明体の斜面に金属反射膜を形成する際、金属反射膜が、EL層をサンドイッチする透明電極や反射電極と接触しないように製造工程を工夫する必要もない。

[0089]

本発明においては、透明体がEL素子を外気から保護するとともに、透明体表面の反射膜によってEL層において発光した光を効率良く外部に取り出すことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

台形状の断面を有する透明体でEL素子を保護する本発明の表示装置の1画素 分の断面図

【図2A】

図1の表示装置の製造工程図

【図2B】

図1の表示装置の製造工程図の続き

【図2C】

図1の表示装置の製造工程図の続き

【図3】

透明体の斜面のみに反射膜を設けた本発明の表示装置の1画素分の断面図 【図4A】

透明体で駆動素子及びE L素子を被覆する本発明の表示装置の部分平面図 【図4B】

図4 AのAA'断面図

【図5】

透明体の一部が球体の一部である本発明の表示装置の1画素分の断面図 【図6】

透明体による凹面鏡の焦平面をEL素子内に位置させる本発明の表示装置の1 画素分の断面図

【図7】

透明基板に溝を設けた本発明の表示装置の1画素分の断面図

【図8】

シリカエアロゲル層を含む基板に入射する光の光路図

【図9】

シリカエアロゲル層を含む基板にEL層から入射する光の光路図

【図10】

EL層を被覆した場合においてEL層からシリカエアロゲル層へ入射する光の 光路図

【図11】

隣接EL層間を絶縁体で埋め込んだ本発明の表示装置の一部断面図

【図12】

隣接EL層間を絶縁体で埋め込んだ本発明の表示装置において、EL層からの 光の反射を説明するための本発明の表示装置の一部断面図

【図13】

図1の構造にハーフミラーを使用するEL光像の断面図

【図14】

図5の構造にハーフミラーを使用するEL光像の断面図

【図15】

ハーフミラー付きEL表示装置を用いたプロジェクターの概念図

【図16】

従来のEL素子の断面図

【図17】

 TiO_2/SiO_2 のペアが4組構造された8層構造のハーフミラー160の膜構成の一例及び垂直入射に対する反射率のグラフ

【図18】

(a)は、波長400nmから700nmの範囲で、入射角30度の範囲における、上述した8層構造のハーフミラー160のS偏光の反射率のグラフ、(b)は、波長400nmから700nmの範囲で、入射角30度の範囲における、上述した8層構造のハーフミラー160のP偏光の反射率のグラフ、(c)は、波長400nmから700nmの範囲で、入射角30度の範囲における、上述した8層構造のハーフミラー160の平均反射率、すなわち(S偏光反射率+P偏光反射率)/2の値を示すグラフ

【図19】

入射角0°における、上述した8層構造のハーフミラー160の反射率、透過率、及び反射波・透過波の位相を示す表

【図20】

波長400nmから700nmの範囲で、入射角30度の範囲における、上述 した8層構造のハーフミラー160のS偏光の反射率の表

【図21】

波長400nmから700nmの範囲で、入射角30度の範囲における、上述 した8層構造のハーフミラー160のP偏光の反射率の表

【図22】

波長400nmから700nmの範囲で、入射角30度の範囲における、上述

した8層構造のハーフミラー160の平均反射率、すなわち、(S偏光反射率+ P偏光反射率)/2の値を示す表

【図23】

光吸収層100aを備えた本発明の表示装置の1画素分の断面図

【図24】

光吸収層100aを備えた本発明の表示装置の1画素分の断面図

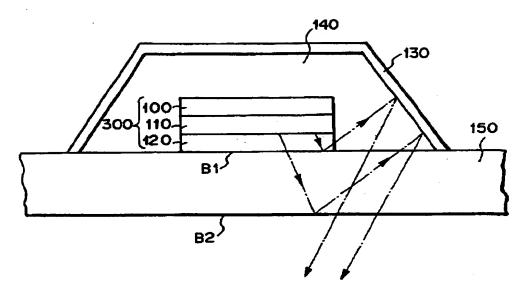
【符号の説明】

- 100 反射電極
- 100a 光吸収層
- 110 EL層
- 120 透明電極
- 130 反射膜
- 140 透明体
- 150 透明基板
- 160 ハーフミラー
- 400 駆動素子
- 600 行配線
- 700 列配線
- 800 絶縁体
- B1 透明電極と透明基板との境界
- B 2 透明基板と空気との境界
- S 透明体の頂上部

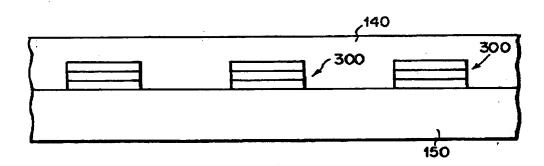
【書類名】

図面

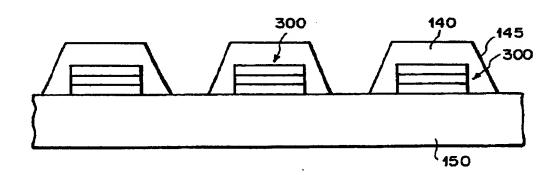
【図1】



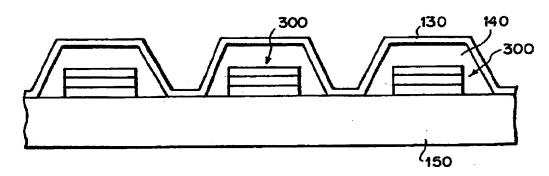
【図2A】



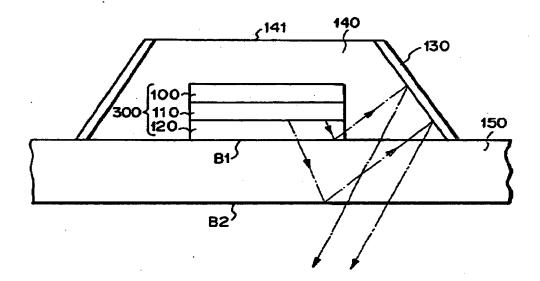
【図2B】



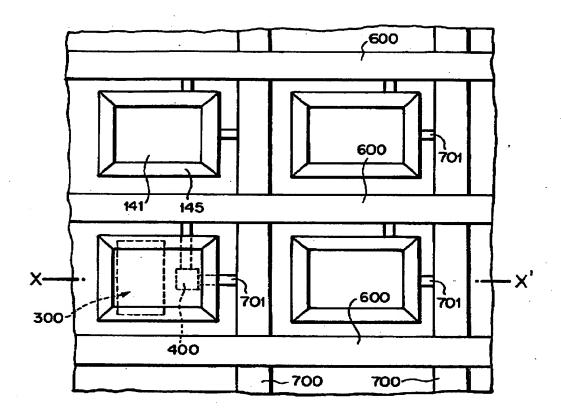
【図2C】



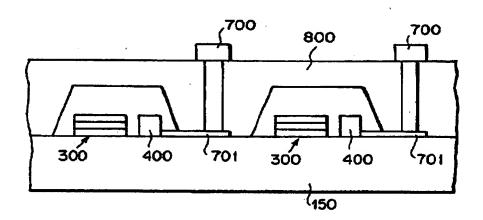
【図3】



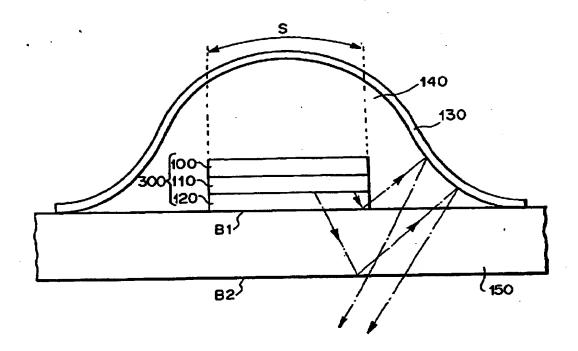
【図4A】



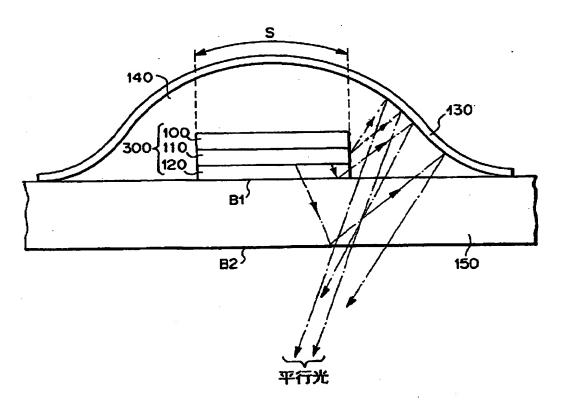
【図4B】



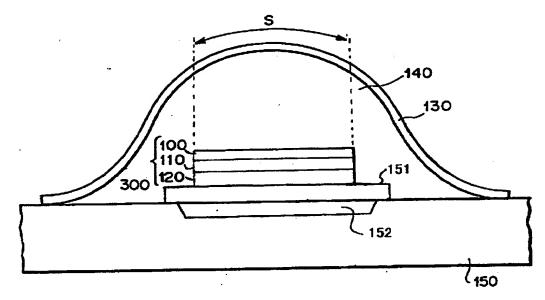
【図5】



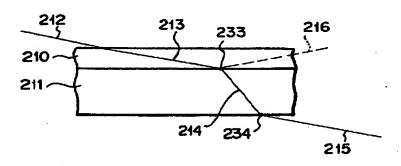
【図6】



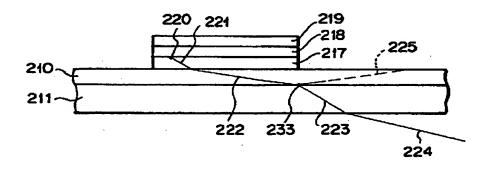
【図7】



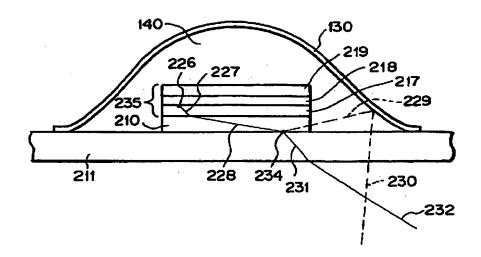
【図8】



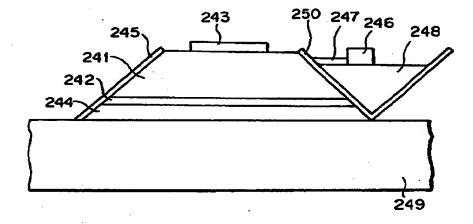
【図9】



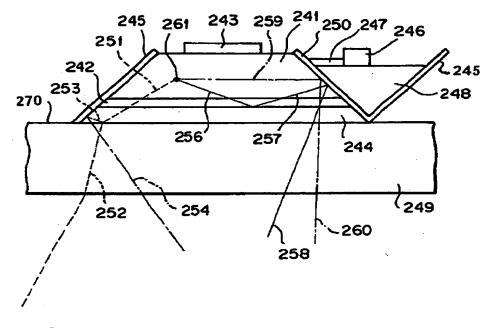
【図10】



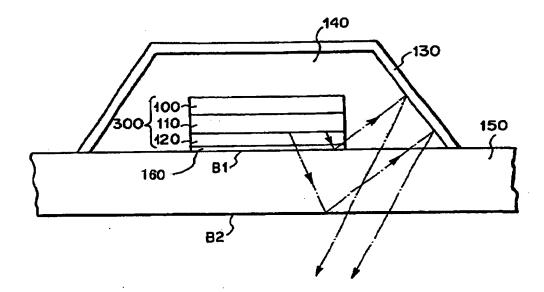
【図11】



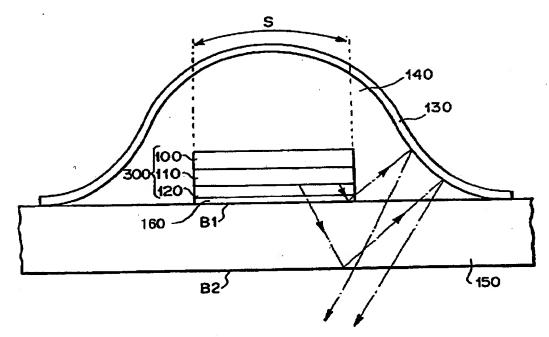
【図12】



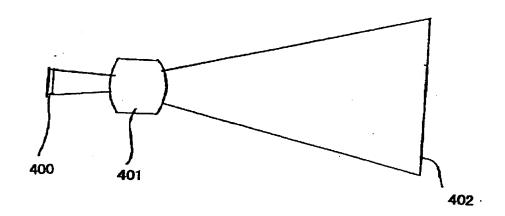
【図13】



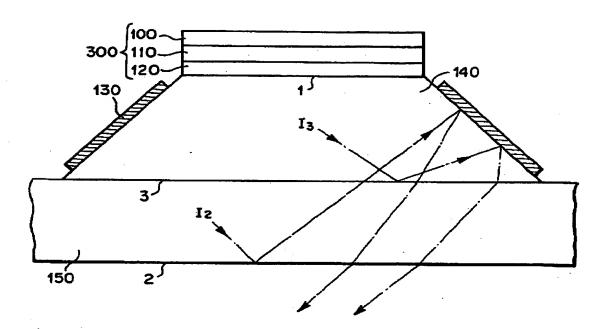
【図14】



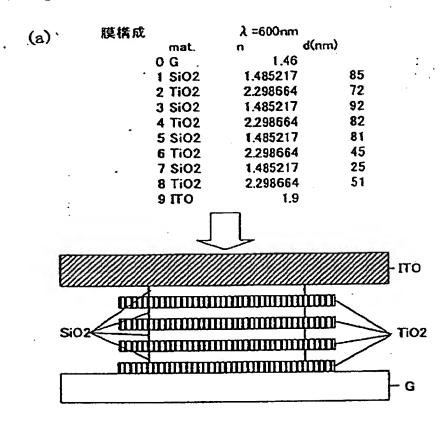
【図15】

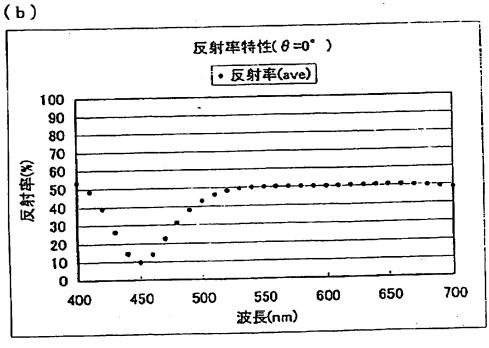


【図16】

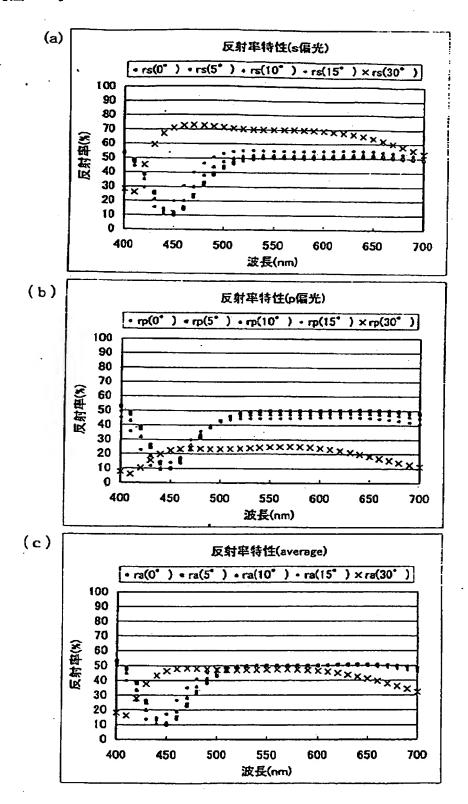


【図17】





【図18】



【図19】

【図20】

the	ta	0	5	10	15	20	25	30
wſ	rs(0°)	rs(5°)	rs(10°)	rs(15°)	rs(20°)	rs(25°)	rs(30°)
400	53.08	3212	53.3949	54.12334	54.48678	52.68927	45.05927	28.26013
410	48.17	7657	48.0306	47.21124	44.43833	37.23653	24.06525	26.01796
420	39.00	1835	38.22824	35.44011	29.42095	19.95582	18.17546	45.26679
430	26.21	536	24.98771	21.19834	15.57016	14.30957	31.02331	59.49687
440	14.30	588	13.43388	11.59921	12.37497	23.11551	45.36075	67.03681
450	9.693	069	10.04325	12.33233	20.02936	35.63604	54.95319	70.74039
460	13.8	806	15.35109	20.54906	30.85611	45.51777	60.55814	72.33646
470	22.45	_	24.35017	30.22547	39.9916	52.03934	63.59624	72.73219
480	31.06	662	32.88383	38.22425	46.44271	56.006	65.04069	72.45333
490	37.91	265	39.47661	43.95743	50.6249	58.23293	65.50564	71.85011
500	42.79	684	44.09124	47.75917	53.15198	59.31593	65.40039	71.17301
510	46.04	912	47.11221	50.11556	54.53563	59.6761	65.01588	70.5896
520	48.07	543	48.95622	51.45082	55.16329	59.61919	64.56017	70.18505
530	49.23	057	49.97527	52.0999	55.32672	59.3 6993	64.16882	69.97028
540	49.80		50.44935	52.32197	55.24517	59.08617	63.90939	69.90289
550	50.00	978	50.59664	52.3144	55.07728	58.86468	63.79144	69.91378
560	50.02		50.58197	52.22066	54.92683	58.74761	63.78334	69.92978
570	49.98		50.5215	52.13468	54.84791	58.73335	63.8316	69.88688
580	49.95		50.48664	52.10589	54.8533	58.79092	63.8771	69.73522
590	49.96		50.50974	52.14688	54.92587	58.87459	63.86576	69.43871
600	50.04	_	50.59212	52.24333	55.03077	58.93546	63.75335	68.97219
610	50.16		50.71388	52.36478	55.12621	58.92895	63.50638	68.31834
620	50.30		50.84343	52.47397	55.17116	58.81831	63.10088	67.46499
630	50.41		50.94525	52.53369	55.12983	58.5754	62.52028	66.40318
640	50.47		50.98534	52.51087	54.97339	58.17983	61.75344	65.12588
650	50.44		50.93435	52.37858	54.6802	57.61763	60.79313	63.62755
660	50.30		50.76881	52.11629	54.23494	56.8798	59.63484	61.90393
670	50.04		50.47107	51.70927	53.62746	55.96098	58.2761	59.95224
680	49.64		50.0289	51.14787	52.85181	54.85879	56.7164	57.77195
690	49.0		49.43447	50.4264	51.90519	53.57301	54.95695	55.36522
700	48.379	985	48.68366	49.54245	50.78745	52.1055	53.00111	52.73804

[図21]

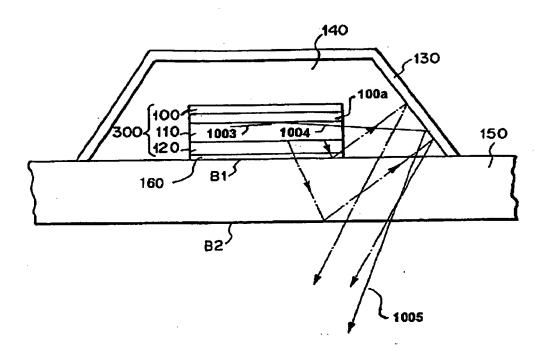
the	ta o	5	10	15	20	25	30
w w	rp(0°)	rp(5°)	rp(10°)	rp(15°)	rp(20°)	rp(25°)	rp(30°)
400	53.08212	52.41265	50.11352	45.19735	35.91914	21.38051	7.714678
410	48.17657	47.0462	43.25155	35.67732	23.52558	10.47469	6.09405
420	39.00835	37,32218	31.98673	22.77523	12.0694	7.138141	10.295
430	26.21536	24.31187	18.8981	11.84362	8.091181	11.22493	15.63376
440	14.30588	13.04836	10.26356	8.979772	12.20714	17.95092	19.73183
450	9.693069	9.706433	10.6241	14.08498	19.74767	23.95304	22.1791
460	13.8806	14.77373	17.64994	22.30504	26.88842	28.21266	23.30821
470	22.45843	23.49275	26.33542	29.93909	32.27244	30.82653	23.60357
480	31.06662	31.84632	33.79384	35.73271	35.86257	32.20508	23.49964
490	37.91265	38.35183	39.29464	39.68754	38.02603	32.77816	23.31682
500	42.79684	42.93243	43.01936	42.17475	39.17749	32.90971	23.24601
510	46.04912	45.94468	45.36773	43.59799	39.67931	32.87423	23.36023
520	48.07543	47.79115	46.72505	44.30494	39.82129	32.85165	23.64426
530	49.23057	48.81779	47.41154	44.57511	39.81848	32.93333	24.03153
540	49.80049	49.30242	47.68153	44.62272	39.81271	33.13805	24.43688
550	50.00978	49.46244	47.73026	44.60017	39.87867	33.43479	24.77926
560	50.02995	49.46219	47.69869	44.60206	40.03564	33.76629	24.99371
570	49.98419	49.41716	47.67725	44.67203	40.26349	34.0683	25.03518
580	49.95105	49.39789	47.71136	44.81339	40.51962	34.28204	24.87747
590	49.96959	49.4358	47.80998	45.00217	40.75334	34.36063	24.51025
600	50.04673	49.53148	47.95609	45.19974	40.9159	34.27074	23.93544
610	50.16668	49.66448	48.11768	45.3632	40.96618	33.9918	23.16418
620	50,30027	49.80294	48.25693	45.45234	40.8728	33.51408	22.2142
630	50.41309	49.91129	48.33689	45.43338	40.61411	32.83644	21.10787
640	50.47114	49.95562	48.32522	45.28025	40.17702	31.96444	19.87064
650	50.44449	49.90677	48.19603	44.97455	39,55558	30.90882	18.52991
660	50.30878	49.74154	47.93003	44.50458	38.74951	29.68432	17.11396
670	50.04538	49.44257	47.51391	43.8641	37.76299	28.30877	15.65106
680	49.64119	48.99798	46.93955	43.05153	36.60391	26.80261	14.1688
690	49.0876	48.4003	46.20294	42.06877	35.28305	25.18815	12.69317
700	48.37985	47.64581	45.3035	40.92075	33.81384	23.48918	11.24807

【図22】

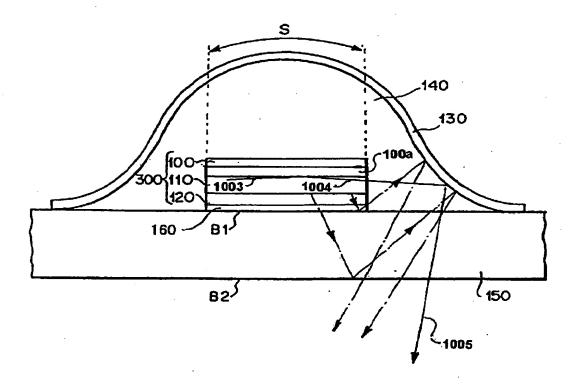
th	ta o	5	10	15	20	25	30
wl	ra(O°)	ra(5°)	ra(10°)	ra(15°)	ra(20°)	ra(25°)	ra(30°)
400	53.08212	52.90377	52.11843	49.84207	44.30421	33.21989	17.9874
410	48.17657	47.5384	45.2314	40.05782	30,38105	17.26997	16.056
420	39.00835	37.77521	33.71342	26.09809	16.01261	12.6568	27.7809
430	26.21536	24.64979	20.04822	13.70689	11.20038	21.12412	37.56531
440	14.30588	13.24112	10.93139	10.67737	17.66133	31.65583	43.38432
450	9.693069	9.874841	11.47822	17.05717	27.69186	39.45311	46,45974
460	13.8806	15.06241	19.0995	26.58057	36.20309	44.3854	47.82233
470	22.45843	23.92146	28.28045	34.96535	42.15589	47.21139	48.16788
480	31.06662	32.36507	36.00905	41.08771	45.93428	48.62288	47.97648
490	37.91265	38.91422	41.62603	45.15622	48.12948	49.1419	47.58346
500	42.79684	43.51183	45.38926	47.66336	49.24671	49.15505	47.20951
510	46.04912	46.52845	47.74164	49.06681	49.67771	48.94506	46.97491
520	48.07543	48.37368	49.08793	49.73411	49.72024	48.70591	46.91465
530	49.23057	49.39653	49.75572	49.95092	49.5942	48.55107	47.00091
540	49.80049	49.87589	50.00175	49.93394	49.44944	48.52372	47.16988
550	50.00978	50.02954	50.02233	49.83873	49.37168	48.61311	47.34652
560	50.02995	50.02208	49.95967	49.76445	49.39162	48.77482	47.46174
570	49.98419	49.96933	49.90597	49.75997	49.49842	48.94995	47.46103
580	49.95105	49.94226	49.90863	49.83334	49.65527	49.07957	47.30635
590	49.96959	49.97277	49.97843	49.96402	49.81396	49.1132	46.97448
600	50.04673	50.0618	50.09971	50.11525	49.92568	49.01204	46.45381
610	50.16668	50.18918	50.24123	50.24471	49.94756	48.74909	45.74126
620	50.30027	50.32318	5 0.36545	50.31175	49.84555	48.30748	44.8396
630	50.41309	50.42827	50.43529	50.28161	49.59476	47.67836	43.75552
640	50.47114	50.47048	50.41805	50.12682	49.17843	46.85894	42.49826
650	50.44449	50.42056	50.2873	49.82738	48.58661	45.85097	41.07873
660	50.30878	50.25518	50.02316	49.36976	47.81466	44.65958	39.50894
670	50.04538	49.95682	49.61159	48.74578	46.86198	43.29243	37.80165
680	49.64119	49.51344	49.04371	47.95167	45.73135	41.75951	35.97038
690	49.0876	48.91739	48.31467	46.98698	44.42803	40.07255	34.0292
700	48.37985	48.16473	47.42298	45.8541	42.95967	38.24515	31.99305

1 5

【図23】



【図24】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 表示装置のEL層で発光した光を高い効率で外部に取り出すとともに 、EL層を含むサンドイッチ構造を外気に触れることがないよう保護する。

【解決手段】 断面が台形状の透明体140でEL素子300が被覆されている。従って、透明体140はEL素子を外気から保護している。又、透明体の表面全体は反射膜で覆われている。反射電極100と透明電極120の間に電圧を印加すると電界発光(EL)層110が発光する。EL層110からの光の一部は透明電極120と透明基板150の境界B1で全反射される。この全反射光は反射膜130で反射され、透明基板150を透過して空気中に取り出される。又、EL層110からの光の他の一部は境界B1で屈折され透明基板150と空気との境界B2で全反射されている。この全反射光は反射膜130で反射され、透明基板150を透過して空気中に取り出される。

【選択図】

図 1

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2001-189722

受付番号 50100908762

書類名特許願

担当官 鈴木 紳 9764

作成日 平成13年 6月29日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】 100065385

【住所又は居所】 東京都港区虎ノ門五丁目13番1号 虎ノ門40

森ビル 山下国際特許事務所

【氏名又は名称】 山下 穣平

出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名

キヤノン株式会社